

学术专场报告人简介



黎大兵 博士，现任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所所务委员、研究员，2001年考入半导体所，导师王占国院士，研究领域 GaN 基光电子材料与器件，2004 年获得博士学位。2004 年-2008 年在日本三重大学从事 AlGaIn 紫外光电材料与器件研究工作，2007 年加入中科院长春光机所。国家杰出青年基金获得者（2017 年），科技部中青年创新领军人才及第四批“万人计划”科技创新领军人才入选者，享受国务院政府特殊津贴。作为项目负责人承担国家重点研发计划课题、国家自然科学基金杰出青年基金等项目 10 余项。担任电子学会青年工作委员会副主任委员、中国金属学会宽禁带委员会委员，OSA 高级会员，《Scientific Reports》、《半导体学报》、《quantum Engineering》等杂志编委，。在 Light: Science & Applications, Advances in Optics and Photonics 等国际期刊上等发表 SCI 论文 100 余篇，申请/授权发明专利 40 余项。

李新征 博士，现任北京大学物理学院院长助理，长聘副教授。2000 年进入半导体所，有幸师从夏建白院士进行半导体量子点的电子结构与光学性质计算研究，2003 年获得硕士学位。之后，于德国与英国完成了博士与博后阶段的学习，2012 年入职北京大学。主要从事凝聚态体系中一些计算方法的发展与应用研究，内容涵盖电子结构与分子动力学两个层面，作为主要研究人员发展了第一性原理路径积分分子动力学方法与著名商业软件 Wien2k 中的 GW 近似部分。基于此，发表论文 50 余篇，出版英文专著、中文教材各一部，2014 年获优青资助，2016 年成果入选中国科学十大进展，2017 年入选青年长江，2019 年获教育部高等学校科学研究自然科学一等奖（3/5），现任 J. Phys.:Condens. Matter 与 Chemical Physics 杂志编委、中国物理学会凝聚态计算专业委员会委员。





韩根全 博士，现任西安电子科技大学教授，2003 年考入半导体所，导师是余金中研究员，研究领域：SiGe 材料生长，2008 年获得博士学位。韩根全博士本科毕业于清华大学材料科学与工程专业，2003 年保送到半导体所直博研究生，研究生期间主要工

作为 SiGe(Sn)材料外延生长和设备研制。2008 年毕业后加入新加坡国立大学从事高端 CMOS 器件研究工作，期间带领一个团队在高迁移率 GeSn 沟道 MOSFET 器件研制方面取得了国际领先的原创性研究成果，被 Semiconductor Today 等网站多次转载报道。2013 年回国到现在主要从事后摩尔新型微电子器件研究，包括高迁移率沟道 CMOS、陡峭亚阈值摆幅负电容晶体管、新型非易失性（类）铁电存储器和超宽禁带 Ga₂O₃ 功率晶体管。韩根全博士围绕后摩尔新型微电子器件取得了一系列重要研究成果，在微电子器件重要会议 IEEE International Electron Devices Meeting/IEEE Symposium on VLSI Technology 和 IEEE Electron Device Letters, IEEE Transactions on Electron Devices 等微电子器件旗舰期刊发表 SCI 论文 200 多篇。主要学术创新工作包括：1) 独辟蹊径推动负电容晶体管从概念到实际器件；2) 发明了新型氧空位调制的类铁电非易失晶体管，比掺杂 HfO₂ 铁电器件操作电压低，耐久性更优；3) 原始创新发明、发展高迁移率 GeSn 沟道晶体管；4) 国际上首次利用智能剥离技术实现高导热衬底（SiC 或者 Si）上的 Ga₂O₃ 材料和功率器件。韩根全博士担任 IEEE Electron Device Letters 编辑（中国大陆唯一）。

佟存柱 博士，现任中科院长春光机所发光学及应用国家重点实验室常务副主任，研究员，2002 年考入半导体所，导师牛智川研究员，研究领域为半导体激光器，2005 年获得博士学位。曾先后在新加坡南洋理工大学和加拿大多伦多大学从事研究工作。获王大珩光学奖、中科院高层次人才项目终期优秀奖。科研成果入选“2015 中国光学重要成果”。主持国家重点研发计划项目、973 课题、自然科学基金重大项目、德国通快、华为委托项目等 15 项。发表学术论文 100 余篇，授权美国发明专利 2 项，中国发明专利 23 项，国际会议邀请报告 20 余次。



产业化专场报告人简介



安俊明 博士，研究员，博士生导师。1992年、1998年和2004年分别在内蒙古大学、大连理工大学和中国科学院半导体研究所获得学士、硕士和博士学位，2006年7月博士后出站。现为中科院半导体所集成光电子学国家重点实验室研究员、博士研究生导师。“国家百千万人才工程”入选人员，并荣获“有突出贡献中青年专家”荣誉称号，享受国务院特殊津贴。中国光电缆及光器件行业“十三五”发展规划编写专家、中国光电子器件产业发展线路图咨询专家。主持科技部

国家重点研发计划课题1项，科技部“863”项目2项，国家自然科学基金面上项目2项，中科院成果转化及产研人才项目3项。在国内外发表论文70余篇，授权专利10项，撰写中文著作AWG一章。2014年“PLC光分路器产业化”获中国科学院科技促进发展奖-科技贡献一等奖，2016年“光分路器及阵列波导光栅芯片设计及制备”获河南省科学技术进步一等奖，2017年“光网络用光分路器芯片及阵列波导光栅芯片关键技术及产业化”获国家科技进步二等奖。

肖希 博士，现任国家信息光电子创新中心总经理，中国信科集团光纤通信技术和网络国家重点实验室副主任，2007年考入半导体所读博，导师余金中研究员，研究领域硅基光电子集成，2010年获得博士学位。2010-2013年期间，历任半导体所助理研究员、副研究员。长期从事硅基光电子集成和高速光调制技术研发，在国内率先实现一系列100G-400G硅光产品的商用化突破，并在国内光通信干线网络中完成国产化替代。拥有授权专利47件，美国专利2件。在Nature Communications、ACS Photonics、Photonics Research、IEEE JSSC等SCI期刊发表文章100余篇，被引近2000次。获中央企业劳动模范、湖北省企业研发人才、湖北省双创战略团队负责人等表彰和奖励。





朱晓鹏 博士，现任北京大族天成半导体技术有限公司总经理。1996 年进入半导体所学习，师从陈良惠院士开展半导体激光器的结构与工艺方面的研究，于 2002 年获得博士学位。在所学习期间和毕业后曾参与 DVD 用 650nm 半导体激光器、852nm DBR 激光器、1480nm 拉曼放大器泵源激光器等研究项目。于 2004 年进入产业界，先后参与微波 MEMS 器件研发、LED 芯片工艺研发和生产线的建设等工作。后从事光纤耦合大功率半导体激光器的设计研发和生产管理工作。于 2011 年共同创建北京大族天成半导体技术有限公司，从事大功率半导体激光器件的封装和系统开发。

邓元明 博士，现任思创医惠科技股份有限公司物联网应用事业部副总经理，1996 年考入半导体所，导师郑厚植研究员，研究领域为量子点材料的 MBE 生长，1999 年获得硕士学位。半导体所毕业后前往美国南加州大学并在 2006 年获得博士学位。博士期间的主要工作是 III/V 半导体材料激光器的 MOCVD 材料生长与器件研究。2006 年回到江苏扬州，首先加入华夏集成光电做 LED 技术及制造管理，后来公司并入扬州中科半导体照明（半导体所参与建立）。2011 年起开始在思创医惠科技做 RFID（无线射频标签）的生产制造及物联网应用，期间和超晶格实验室王开友、吴南健、冯鹏老师一起尝试将带温度传感的 RFID 芯片产业化。



魏志坚 博士，中国科技大学物理学士，美国南加州大学物理硕士和电子工程博士。1995 年进入半导体所超晶格国家重点实验室学习工作，跟随导师郑厚植院士从事低维量子输运物理研究；在美国学习期间先后从事自组织量子点(SAQD)MBE 生长机制、SAQD 探测器、大规模 VCSEL 阵列、VCSEL 偏振控制等课题研究。科技部重点研发计划“光接入用 25G/50G/100G PON 硅基光电子芯片与子系统”项目负责人、首席科学家。广东省硅基光电子工程中心负责人。2018 年 2 月加入迅特通信，现任集团首席技术官及副总经理，负责技术及产品长期战略规划。加入迅特前曾服务于 EMCORE、JDSU、Avago、CISCO 等公司，先后负责数据通信产品研发、Marketing 及管理工作；在通信光芯片、光电器件、光收发模块、交换设备方面拥有 20 多年行业前沿经验。

杨国文 博士，度亘激光技术有限公司创始人。1988年免试进入半导体所，导师陈良惠院士和王启明院士，从事光电子领域半导体激光器的研究，1997年获得博士学位。在半导体光电子领域拥有30余年的研究与产品开发经验，其中10年的半导体所研究经历，15年的海外产品开发经历，5年的创业经历。曾加盟国际著名公司康宁(CORNING)和捷迪讯(JDSU)担任核心技术职务。2013年作为中科院高层次人才计划回国，2017年创立度亘(DoGain)激光技术有限公司，苏州工业园区重大领军人才。杨国文博士是教育部首批“全国优秀博士论文奖”“中国科学院院长奖学金特别奖”“中科院科技进步一等奖”和美国公司“总裁杰出成就奖”获得者。先后完成30余项具有非常挑战性的项目，取得众多国际领先的成果。主持开发的世界领先的三代通讯用单模半导体激光芯片，由于其极高的光功率密度和可靠性要求，被称为芯片的皇冠明珠。多年来发表学术论文80余篇，专利10余项，各类成果奖励与荣誉20余项。



莫庆伟 博士，现任德豪润达研发副总裁，1996年考入半导体所，导师王占国院士，研究低维半导体材料应力应变机制，1998年获硕士学位。1999-2003年于University of Texas at Austin电子系研究量子点激光器和Air-Gap VCSEL，获博士学位。回国前在硅谷就职于 Philips Lumileds，实现创纪录的高光密度大功率LED并量产全球首例全LED汽车前照灯(Audi R8)。曾获 Frost & Sullivan 全球年度技术创新奖和 Daimler Special Award Innovation(戴姆勒特别创新奖)等奖项。
